

## LOT DE TRANSISTORS BIPOLAIRES SILICIUM

FICHE N° 3430

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : Inconnu

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electrotechnique

Organisme : Université de Nantes - Institut universitaire de technologie (IUT)

Ville : Nantes

Modèle :

Matériaux : Métal

### Description

Ce lot est composé de transistors bipolaires au silicium.

Les transistors bipolaires possèdent deux jonctions PN, c'est-à-dire une zone où le dopage varie brusquement passant d'un dopage p à un dopage n. La première jonction est directe, la seconde en inverse. L'utilisation de ces deux jonctions permet d'amplifier le courant, c'est l'effet transistor.

Le dopage est une introduction de petites impuretés dans un matériau. Cette introduction produit un excès ou un déficit d'électrons. Lorsque des semi-conducteurs, dopés différemment, sont mis en contact, une jonction est créée. Cette jonction permet de contrôler la direction et la quantité du courant.

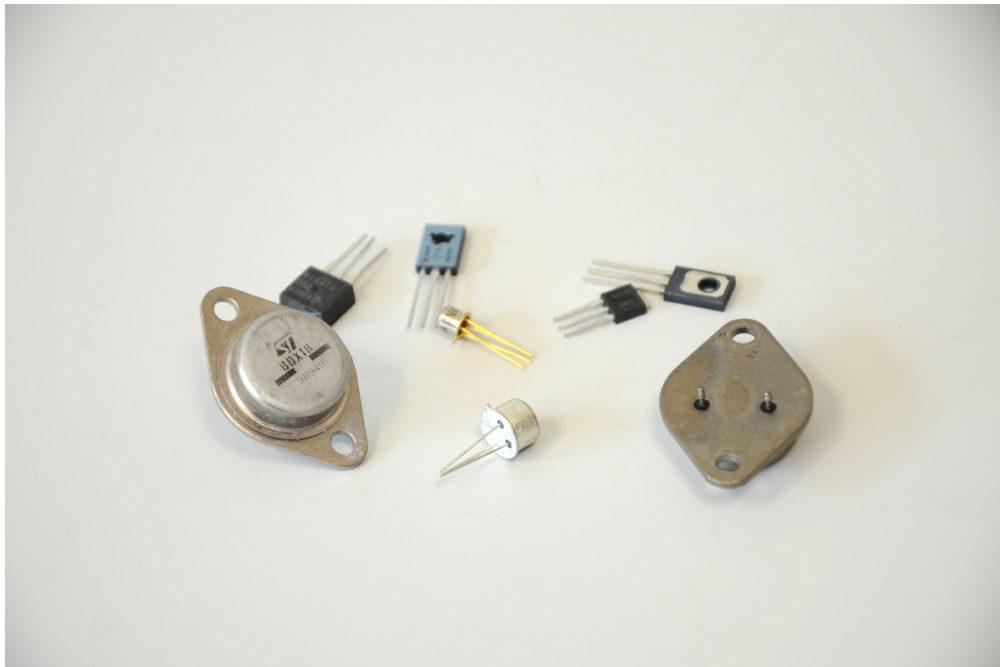
### Utilisation

Ces composants sont conservés par l'Institut Universitaire de Technologie. Ces éléments sont utilisés par les étudiants du département Génie électrique (GEI) de l'IUT dans le cadre de cours de conception de systèmes électriques en bureau d'étude.

Ces transistors étaient utilisés dans des circuits électroniques.

L'utilisation de silicium, élément chimique moins sensible à la température que le germanium, permet de diminuer la taille des transistors.





**Pour nous citer :**

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lot de transistors bipolaires silicium (Inconnu), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4110>, consulté le 2026-07-24